

(11)特許出願公開番号

特開2001-217503

(P2001-217503A)

(43)公開日 平成13年8月10日(2001.8.10)

(51)Int.Cl.	識別記号	F I	テレポート(参考)
H 0 1 S 5/22		H 0 1 S 5/22	5 F 0 4 1
H 0 1 L 33/00		H 0 1 L 33/00	C 5 F 0 7 3

検査請求 未請求 請求項の数? OL (全 12 頁)

(21)出願番号	特願2000-25929(P2000-25929)	(71)出願人	000005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地
(22)出願日	平成12年2月3日(2000.2.3)	(72)発明者	木戸口 勲 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(72)発明者	石橋 明彦 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内
		(74)代理人	100097445 弁理士 岩橋 文雄 (外2名)

最終頁に続<

(54)【発明の名称】 GaN系半導体発光素子およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 信頼性の高いGaN系半導体レーザを歩留まりよく作製する。

【解決手段】 基板上に n -AlGaInクラッド層まで堆積した後、該 n -AlGaInクラッド層をリッジ状に加工し、リッジ側面とリセス底部とを SiN_x で被覆し、 n -AlGaInクラッド層のC面を種結晶として n -光ガイド層、活性層、 p -光ガイド層、 p クラッド層、 p -GaIn層を成長させて、GaIn系半導体レーザを作製することで、信頼性の高い単一横モードのレーザを歩留まりよく作製できる。

